## **JE 3638682 A**1

) ® BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

<sup>®</sup> Offenlegungsschrift
<sup>®</sup> DE 3638682 A1

(5) Int. Ci. 4: H 01 J 37/244

H 01 J 37/256 // H01L 21/66, H01J 37/141



DEUTSCHES PATENTAMT

 (2) Aktenzeichen:
 P 36 38 682.0

 (2) Anmeldetag:
 13. 11. 86

 (3) Offenlegungstag:
 19. 5. 88

Bahördanaiggalam

(7) Anmelder:

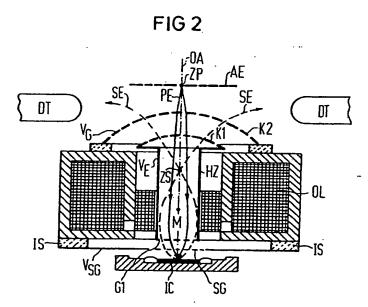
Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München, DE

② Erfinder:

Feuerbaum, Hans-Peter, Dr.-Ing., 8000 München, DE; Frosien, Jürgen, Dr.-Ing., 8012 Ottobrunn, DE

(5) Spektrometerobjektiv für Korpuskularstrahlmeßtechnik

Das erfindungsgemäße Spektrometerobjektiv besteht im wesentlichen aus einer kurzbrennweitigen, weitgehend asymmetrischen Objektivlinse (OL), einem innerhalb der Objektivlinse (OL) symmetrisch zur optischen Achse (OA) angeordneten Ablenksystem (DS) und einem elektrostatischen Gegenfeldspektrometer, das eine Elektrodenanordnung (SG, G1) zur Beschleunigung der auf einer Probe (IC) ausgelösten Sekundärkorpuskeln (SE) und ein ein kugelsymmetrisches Gegenfeld aufbauendes Elektrodenpaar (K1, K2) aufweist. Die Elektrodenanordnung (SG, G1) zum Absaugen und Beschleunigen der Sekundärkorpuskeln (SE) besteht aus einer im Bereich des unteren Polschuhes der Objektivfinse (OL) angeordneten Gitterelektrode (G1) und einer im Korpuskularstrahlengang unmittelbar oberhalb der Probe (IC) angeordneten ebenen Elektrode (SG), die mit eincm zwischen dem Probenpotential und dem Potential (V<sub>F</sub>) der Elektrode (G1) liegenden Potential (VSG) beaufschlagt



## Patentansprüche

1. Spektrometerobjektiv für Korpuskularstrahlmeßgeräte mit einer Objektivlinse (OL) und einem Gegenfeldspektrometer die eine korpuskularopti- 5 sche Einheit zur Fokussierung eines primären Korpuskularstrahls (PE) bilden, wobei das Gegenfeldspektrometer eine auf einem ersten Potential  $(V_E)$ liegende Elektrodenanordnung (G 1) zur Beschleunigung der auf einer Probe (IC) ausgelösten Sekun- 10 därkorpuskeln (SE) in Richtung der Objektivlinse (OL) und eine zweite Elektrodenanordnung (K 1, K2) zum Aufbau einer die Sekundärkorpuskeln (SE) abbremsenden Potentialbarriere (VG) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß der ersten 15 Elektrodenanordnung (G1) eine im Korpuskularstrahlengang unmittelbar oberhalb der Probe (IC) angeordnete, auf einem zweiten Potential (VsG) liegende Elektrode (SG) vorgelagert ist.

2. Spektrometerobjektiv nach Anspruch 1, dadurch 20 gekennzeichnet, daß die Elektrode (SG) und die Probe (IC) auf dem gleichen Potential liegen.

3. Spektrometerobjektiv nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrode (SG) mit einem Potential ( $V_{SG}$ ) zwischen 0 und 100 Volt 25 beaufschlagt ist.

4. Spektrometerobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrode (SG) am unteren Polschuh der Objektivlinse (OL) gehaltert ist.

5. Spektrometerobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrode (SG) im Polschuhspalt gehaltert ist.

6. Spektrometerobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrode (SG) einen ringförmigen Halterungsteil aufweist.

7. Spektrometerobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 6, gekennzeichnet durch ein Gitter als Elektrode (SG).

8. Spektrometerobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 5, gekennzeichnet durch eine Blende als Elektrode (SG).

9. Spektrometerobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite 45 Elektrodenanordnung (K 1, K 2) oberhalb der Objektivlinse (OL) angeordnet ist.

10. Spektrometerobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Elektrodenanordnung (K 1, K 2) innerhalb der Objektivlinse (OL) angeordnet ist.

11. Spektrometerobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Elektrodenanordnung (K 1, K 2) eine erste (K 1) und eine zweite Elektrode (K2) aufweist, daß die 55 erste Elektrode (K 1) Teil der Oberfläche einer ersten Kugel mit einem ersten Radius (R1) ist, daß die zweite Elektrode (K2) Teil der Oberfläche einer zweiten Kugel mit einem zweiten Radius (R2) ist, wobei die Mittelpunkte der ersten und der zweiten 60 Kugel in einem auf der optischen Achse (OA) der Objektivlinse (OL) liegenden Punkt (ZS) zusammenfallen und daß die erste und die zweite Elektrode (K 1, K 2) derart mit Potentialen ( $V_E$ ,  $V_C$ ) beaufschlagt sind, daß sich im Raumbereich zwischen 65 diesen Elektroden ein kugelsymmetrisches Gegenfeld aufbaut.

12. Spektrometerobjektiv nach einem der Ansprü-

che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Zentrum (ZS) des kugelsymmetrischen Gegenfeldes in einem von elektrischen Feldern freien Raum liegt.

13. Spektrometerobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 12, gekennzeichnet durch ein in die Objektivlinse (OL) integriertes und oberhalb des ersten Elektrodenanordnung (G 1) angeordnetes Ablenksystem (DS).

14. Spektrometerobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Zentrum (ZS) des kugelsymmetrischen Gegenfeldes im Mittelpunkt (M) des Ablenksystems (DS) liegt.

15. Spektrometerobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Ablenksystem (DS, MD, ED) nach Art eines Wien'schen Filters ausgebildet ist.

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Spektrometerobjektiv für Korpuskularstrahlmeßgeräte nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Ein solches Spektrometerobjektiv ist aus der Veröffentlichung von E. Plies."A new objective lens with inspectrometer for electrom beam testing", Proc. XIth Int. Cong. on Electron Microscopy, Kyoto, 31, 08, -07, 09, 86, Seiten 625-626 bekannt. Dieses Spektrometerobjektiv, das im wesentlichen aus einer kurzbrennweitigen magnetischen Objektivlinse, einer innerhalb der Objektivlinse angeordneten Ablenkeinheit und einem elektrostatischen Gegenfeldspektrometer besteht, bildet die Komponente der elektronenoptischen Säule eines Elektronenstrahlmeßgerätes, mit der sowohl die von einer Hochstromelektronenquelle emittierten Primärelektronen als auch die auf einer Probe ausgelösten Sekundärelektronen in einen auf der optischen Achse des Systems liegenden Punkt fokussiert werden. Der Fokus der auf hohe kinetische Energien beschleunigten Sekundärelektronen liegt hierbei im Zentrum eines kugelsymmetrischen Gegenfeldes, das man in einem oberhalb der Objektivlinse angeordneten Spektrometerteil mit Hilfe eines entsprechend ausgebildeten Elektrodenpaares erzeugt. Um eine gute Fokussierung der Sekundärelektronen zu gewährleisten ist man gezwungen, die unmittelbar oberhalb der Probe angeordnete Absaugelektrode auf ein hohes positives Potential zu legen. Hohe Absaugfelder ( $E \approx 1$  bis 2 kV/ mm) im Bereich der Probe sollten aber insbesondere bei der Überprüfung der Funktionsweise mikroelektronischer Bauelemente vermieden werden. Darüber hinaus wirken sich Störungen der Homogenität des Absaugfeldes, wie sie insbesondere bei stark strukturierten Proben auftreten, ungünstig auf die Ortsauflösung (

Durchmesser der Elektronensonde auf der Probe) des Elektronenstrahlmeßgerätes aus.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein Spektrometerobjektiv der eingangs genannten Art anzugeben, dessen Abbildungseigenschaften nicht von der Struktur der untersuchten Probe beeinflußt wird. Außerdem sollen Schädigungen der Probe durch hohe Absaugfelder vermieden werden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Spektrometerobjektiv der eingangs genannten Art gelöst, welches die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 aufweist.

Der mit der Erfindung erzielbare Vorteil besteht insbesondere darin, daß auch stark strukturierte Proben, insbesondere hochintegrierte Schaltungen auf Halblei-

4

terwafern, in einem Korpuskularstrahlmeßgerät mit hoher Ortsauflösung untersucht werden können.

Die Ansprüche 2 bis 15 sind auf bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung gerichtet.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen erläutert. Dabei zeigen die

Fig. 1 bis 3 erfindungsgemäße Spektrometerobjektive.

Das in den Fig. 1 und 2 schematisch dargestellte 10 Spektrometerobjektiv besteht im wesentlichen aus einer kurzbrennweitigen, weitgehend asymmetrischen Objektivlinse OL, einem innerhalb der Magnetlinse OL symmetrisch zur optischen Achse OA angeordneten einstufigen Ablenksystem DS und einem elektrostati- 15 schen Gegenfeldspektrometer, das eine Elektrodenanordnung SG, G1 zur Beschleunigung der auf einer Probe IC, vorzugsweise in der integrierten Schaltung, ausgelösten Sekundärelektronen SE und ein ein kugelsymmetrisches Gegenfeld erzeugendes Elektrodenpaar 20 K 1/K 2 aufweist. Das aus Objektivlinse OL, Ablenkeinheit DS und Spektrometer bestehende System bildet die Komponente der elektronenoptischen Säule des in Fig. 1 schematisch dargestellten Elektronenstrahlmeßgerätes, mit der die von einem Strahlerzeuger G emit- 25 tierten Primärelektronen PE fokussiert und abgelenkt und die auf der Probe IC ausgelösten Sekundärelektronen SE in einen auf der optischen Achse OA liegenden Punkt ZS abgebildet werden. Zur Erzeugung einer feinen Elektronensonde mit einem Strahlquerschnitt im 30 Submikrometerbereich ( $d_{PE} \approx 0.1 \, \mu \text{m}$ ) bildet man die Elektronenquelle Q oder deren durch Kondensorlinsen KL erzeugtes Zwischenbild ZP mit Hilfe des Spektrometerobjektivs verkleinert auf die in unmittelbarer Nähe der hinteren Brennebene der Magnetlinse OL ange- 35 ordnete Probe IC ab. Die Positionierung des Primärelektronenstrahles PE auf einem nicht näher bezeichneten Punkt der Probe IC, bzw. dessen zeilenförmige Ablenkung erfolgt mit Hilfe der Ablenkeinheit DS.

Zum Nachweis der am Auftreffpunkt der Primärelek- 40 tronen PE ausgelösten und in einem großen Raumwinkelbereich emittierten niederenergetischen Sekundärlektronen ( $E_{SE}$  < 50 eV) werden diese von der Probe IC abgesaugt und in einen homogenen elektrischen Feld in Richtung der Objektivlinse OL auf kinetische Energien 45 zwischen etwa 1 und 5 keV beschleunigt. Erfindungsgemäß besteht die Elektrodenanordnung zum Absaugen und Beschleunigen der Sekundärelektronen SE aus einer im Strahlengang unmittelbar oberhalb der Probe IC angeordneten ebenen Elektrode SG und einer im Be- 50 reich des unteren Polschuhes der Objektivlinse OL angeordneten Gitterelektrode G1, die vorzugsweise auf hohem positiven Potential  $V_E$  von etwa 1 bis 5 kV liegt. Wird die isoliert am unteren Polschuh oder innerhalb des Polschuhspaltes gehalterte Elektrode SG mit einem 55 zwischen dem Probenpotential (normalerweise Erdpotential) und dem Potential Vr der Elektrode G 1 liegenden Potential Vscii insbesondere mit einem Potential zwischen 0 und 100 Volt beaufschlagt, kann man erreichen, daß die Feldstärke im Bereich der Probe IC unter- 60 halb eines kritischen Wertes bleibt. Außerdem ist sichergestellt, das Unebenheiten der Probenoberfläche keinen Einfluß auf die Homogenität des zwischen den Elektroden SG und G1 aufgebauten elektrischen Feldes haben. Die untere Elektrode SG ist hierbei vorzugs- 65 weise als Gitter ausgebildet und weist einen durch Isolatoren IS vom unteren Polschuh der Objektivlinse OL getrennten ringförmigen Halterungsteil auf, der mit ei-

ner variablen Spannungsquelle leitend verbunden ist. Anstelle der Gitterelektrode G1 kann selbstverständlich auch eine Lochblende verwendet werden. Die beschleunigten Sekundärelektronen SE durchlaufen die 5 Gitterelektrode G1 und gelangen in das Magnetfeld der Objektivlinse OL zwischen den Polschuhen, in dem sie in einen auf der optischen Achse OA liegenden Punkt ZS fokussiert werden. Die Lage dieses Fokussierungspunktes ZS, der als reelles Zwischenbild der unterhalb der Probe IC liegenden virtuellen Quelle (kleinster Kaustikquerschnitt aller virtuellen Sekundärelektronenbahnen unterhalb der Probe IC) der Sekundärelektronen SE zu interpretieren ist, wird hierbei von der Höhe des an der Gitterelektrode G1 anliegenden Potentials  $V_E$  und der von der Primärelektronenenergie abhängigen Magnetfeldstärke im Polschuhspalt bestimmt. Eine gute Fokussierung der Sekundärelektronen SE im Feld der Objektivlinse OL ist erst durch deren Beschleunigung auf hohe kinetische Energien  $(E_{SE} = 1 \text{ bis 5 KeV})$  gewährleistet, da nur dann die Bildweiten der am Meßpunkt mit unterschiedlichen Energien  $(O < E_O < 50 \text{ eV})$  emittierten Sekundärelektronen SE nahezu gleich sind. Da die Primärelektronen PE die Objektivlinse OL bei hohen Beschleunigungspotentialen V<sub>E</sub> ebenfalls mit hoher Energie durchlaufen, wird auch der nachteilige Einfluß des Boersch-Effektes (Coulomb-Wechselwirkung der Elektronen im Primärstrahl) auf den Sondendurchmesser in diesem Teil des elektronenoptischen Strahlengangs reduziert.

Die Abbremsung und die Energieanalyse der Sekundärelektronen SE erfolgt innerhalb, oder wie in Fig. 1 und 2 dargestellt, oberhalb der Objektivlinse OL in einem kugelsymmetrischen elektrischen Gegenfeld, daß man im Raumbereich zwischen zwei nahezu halbkugelförmigen, auf unterschiedlichem Potential  $V_E$  bzw.  $V_G$ liegenden Gitterelektroden K 1 und K2 aufbaut. Während die untere Gitterelektrode K1 auf dem Potential Vi: der Elektrode G 1 liegt, wird die obere Gitterelektrode K2 üblicherweise mit Potentialen zwischen etwa -15 Volt und +15 Volt beaufschlagt. Oberhalb der das Gegenfeld aufbauenden Elektrodenanordnung K 1, K 2 kann noch eine in den Fig. 1 und 2 nicht dargestellte Abschirmelektrode vorgesehen sein, deren Potential vorzugsweise gleich dem Potential  $V_G$  der Elektrode K 2 gewählt wird.

Um Lamordrehungen der Sekundärelektronen SE innerhalb der Objektivlinse OL zu vermeiden, sollte der Sekundärelektronenfokus ZS genügend weit oberhalb der Polschuhe und der Ablenkeinheit DS liegen. Die Fokussierung der Sekundärelektronen in einen oberhalb der Ablenkeinheit DS liegenden Punkt ZS der optischen Achse OA ist hierbei um so besser möglich, je kleiner die Energie der Primärelektronen PE und je höher das die Sekundärelektronen SE beschleunigende Potential V: der Elektrode G1 gewählt wird. Um Störungen der Bahnbewegung der Sekundärelektronen SE durch elektrische Felder innerhalb der Objektivlinse OL zu vermeiden, ist die Gitterelektrode K1 über einen konzentrisch zur optischen Achse OA angeordneten Hohlzylinder HZ leitend mit der Elektrode G1 verbunden

Ein vom Emissionswinkel unabhängiger Nachweis der Sekundärelektronen SE ist nur dann gewährleistet, wenn deren Bahnen parallel zu den Feldlinien des elektrischen Gegenfeldes und damit senkrecht zur Oberfläche der Elektroden K1 und K2 verlaufen. Diese Bedingung ist für den Zentralstrahl der Sekundärelektronenkeule immer dann erfüllt, wenn der gemeinsame Mittel-

punkt der Gitterelektroden K1 und K2 auf der optischen Achse OA in der Mitte M des Ablenksystems DS liegt. Da die Sekundärelektronenkeule beim Rastern des Primärstrahls um diesen Punkt gekippt wird, ist ein orts- und winkelunabhängiger Nachweis der in Richtung der Symmetrieachse der Keule emittierten Sekundärelektronen SE in einem oder mehreren symmetrisch zur optischen Achse OA angeordneten Detektoren DT gewährleistet. Bei Verwendung einer symmetrischen Detektoranordnung kann oberhalb der Gitterelektro- 10 den K1 und K2 noch ein auf negativem Potential liegende Elektrode AE zum Ablenken der in Richtung der optischen Achse OA emittierten Sekundärelektronen

SE vorgesehen sein. Das in Fig. 3 dargestellte Spektrometerobjektiv be- 15 steht im wesentlichen aus einer kurzbrennweitigen Objektivlinse OL, einer innerhalb der Objektivlinse OL symmetrisch zur optischen Achse OA angeordneten Ablenkeinheit DS und einem elektrostatischen Gegenfeldspektrometer, das die aus Fig. 1 und 2 bekannte 20 Elektrodenanordnung SG/G 1 zum Absaugen und Beschleunigen der Sekundärelektronen SE und eine ein kugelsymmetrisches Gegenfeld erzeugende Elektrodenanordnung K 1/K 2 aufweist. Das aus Objektivlinse OL, Ablenkeinheit DS und Gegenfeldspektrometer be- 25 stehende System bildet die Komponente der elektronenoptischen Säüle eines Elektronenstrahlmeßgerätes, mit der die von einer Hochstromelektronenquelle emittierten Primärelektronen PE fokussiert und abgelenkt und die auf der Probe IC ausgelösten Sekundärelektro- 30 nen SE vorzugsweise in das auf der optischen Achse OA liegende Zentrum ZS des kugelsymmetrischen Gegenfeldes fokussiert werden. Dieses Gegenfeld wird mit Hilfe der in einem Gehäuse GH oberhalb der Objektivlinse OL angeordneten Gitterelektroden K1 und K2 35 erzeugt, die jeweils Teile der Oberfläche konzentrischer Kugeln mit unterschiedlichen Radien R1 bzw. R2  $(R_1 \approx 30 \text{ mm}, R_2 \approx 34 \text{ mm})$  bilden. Da der das Zentrum des Gegenfeldes definierende Mittelpunkt ZS der den sehr weit oberhalb der vorzugsweise aus magnetischen und elektrischen Ablenkelementen MD bzw. ED bestehenden Ablenkeinheit DS und des Polschuhspaltes liegt, werden Lamordrehungen der Sekundärelektronen SE nach dem Durchlaufen des Zwischenbildes ZS vermie- 45 den. Zur Erzeugung eines von elektrischen Feldern freien Raumes im Bereich der Sekundärelektronenfokus ZS ist innerhalb des von einem ringförmigen Sekundärelektronendetektor DT abgeschlossenen Gehäuses GH, in dem sich außer den Elektroden K1 und K2 noch ein 50 Abschirmgitter BG und eine Channelplate CP oder ein Halbleiterdetektor zum Nachweis der Sekundärelektronen SE befinden, ein aus drei Teilen bestehender, symmetrisch zur optischen Achse OA angeordneter Hohlzylinder HZ vorgesehen. Während der obere Teil 55 dieses sich im Bereich der Objektivlinse OL verjüngenden Hohlzylinders HZ leitend mit dem auf einem Potential  $V_E$  liegenden Elektrode K 1 verbunden ist, wird dessen unterer Teil probenseitig von der ebenfalls auf dem Potential V<sub>E</sub> zwischen etwa 0,5 und 5 kV, insbesondere 60 2 kV liegenden Elektrode G1 abgeschlossen. Der von dem magnetischen Ablenkelement MD umgebene mittlere Zylinderteil ist hierbei wie in dem bekannten Spektrometerobjektiv nach E. Plies als elektrostatischer Achtpolablenker ED ausgebildet, dessen Einzelelektro- 65 den zum Ablenken des Primärstrahles mit einem weiteren Potential Vx beaufschlagt werden. Auf den Stigmator ST zur Kompensation des axialen Astigmatismus

kann verzichtet werden, wenn man die Elektroden des Achtpolablenkers ED mit geeigneten Zusatzspannungen belegt.

Um Ablenkungen der Sekundärelektronen SE zu vermeiden, sind die mit Hilfe der Ablenkeinheit DS erzeugten homogenen elektrischen und magnetischen Feldern nach Art eines Wien'schen Filters räumlich so zueinander orientiert, daß deren Feldvektoren senkrecht aufeinander und jeweils senkrecht auf dem Geschwindigkeitsvektor der Sekundärelektronen SE stehen. Die Feldstärken E bzw. B sind hierbei so aufeinander abgestimmt, das die auf die Sekundärelektronen SE wirkende Lorenzkraft verschwindet (d. h. es muß gelten  $E/B = v_{SE}$  wobei  $v_{SE}$  die mittlere Geschwindigkeit der Sekundärelektronen SE im Bereich der Ablenkeinheit DS bezeichnet).

Spektrometerobjektive besitzen aufgrund des dem fokussierenden Magnetfeld der Objektivlinse überlagerten elektrischen Verzögerungsfeldes deutlich kleinere Farb- und Öffnungsfehlerkonstanten als magnetische Einzellinsen. Da die Abbildungseigenschaften solcher Systeme im wesentlichen von der Homogenität und der Stärke des Verzögerungsfeldes bestimmt wird, konnte die theoretisch mögliche Auflösungsgrenze (Strahldurchmesser auf der Probe) infolge der an der Probenoberfläche vorhandenen Feldverzerrung in konventionellen Spektrometerobjektiven nicht erreicht werden. Erst mit der erfindungsgemäßen Entkopplung des Verzögerungsfeldes von der jeweiligen Probe kommen die verbesserten Abbildungseigenschaften dieser elektrostatisch-magnetischen Linse uneingeschränkt zur Geltung.

Die Erfindung ist selbstverständlich nicht auf die in den Fig. 1 bis 3 dargestellten Ausführungsbeispiele beschränkt. So ist es beispielsweise möglich, die das kugelsymmetrische Gegenfeld erzeugende Elektrodenanordnung K1, K2 und ggf. auch das Detektorsystem vollständig innerhalb der Objektivlinse OL anzuordnen.

Die Fig. 2 und 3 betreffen Spektrometerobjektive mit Gitterelektroden K1 und K2 zugeordneten Kugeln 40 integriertem Ablenksystem DS. Dieses Ablenksystem DS kann selbstverständlich auch in konventioneller Weise im Korpuskularstrahlengang oberhalb der Objektivlinse OL angeordnet werden. Hierbei muß man allerdings in Kauf nehmen, daß sich mit der Verlängerung des Strahlenganges auch der nachteilige Einfluß des Boersch-Effektes auf den Sondendurchmesser vergrößert

Anstelle der kugelsymmetrischen Elektroden K 1, K 2 kann auch ein ebenes Elektrodenpaar zur Erzeugung des Gegenfeldes verwendet werden. Ein vom Emissionswinkel unabhängiger Nachweis der Sekundärelektronen SE ist mit einer solchen Anordnung allerdings nicht mehr möglich.

## - Leerseite -

.

· •

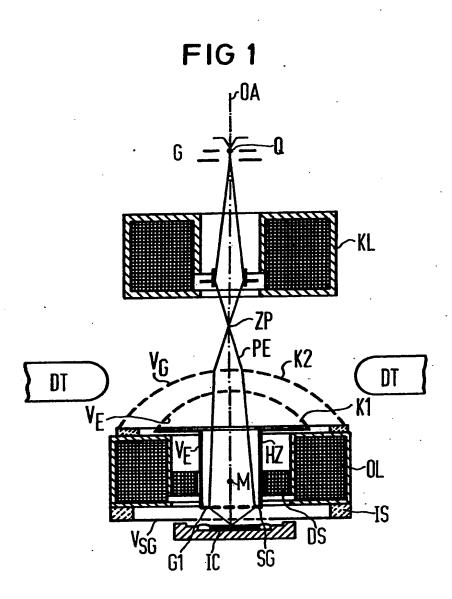
.

Įt

Nummer:
Int. Cl.4:
Anmeldetag:
Offenlegungstag:

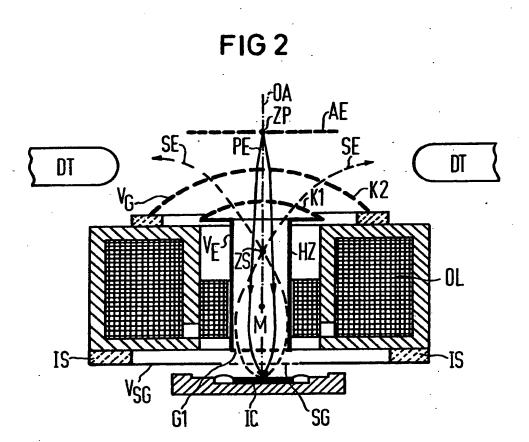
36 38 682 H 01 J 37/244 13. November 1986 19. Mai 1988

1/3



2/3

3638682



3/3

3638682

